

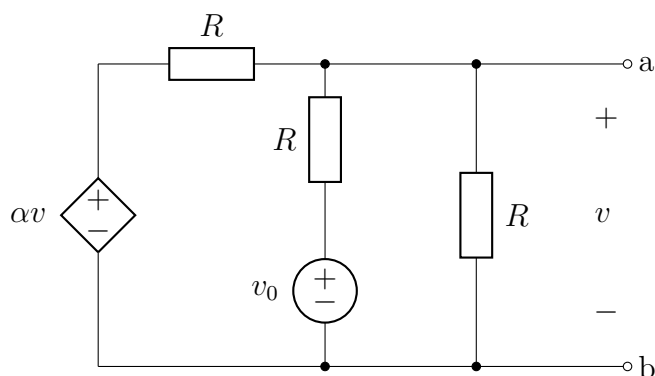
# Tentamen i ETE115 Ellära och elektronik, 4/6 2013

Tillåtna hjälpmedel: Formelsamling i kretsteori.

Observera att uppgifterna inte är sorterade i svårighetsordning. Alla lösningar skall ges tydliga motiveringar.

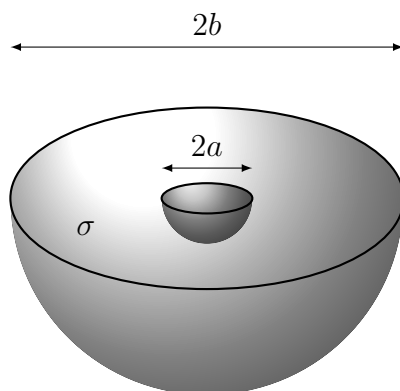
## 1

Bestäm Thévenin-ekvivalenten med avseende på nodparet a-b i nedanstående krets.



## 2

En elektrod i form av en metallisk halvsfär med radie  $a$  sänks ned i ett större halvsfäriskt metallskal med radie  $b$  fyllt med ett material med ledningsförmåga  $\sigma$ , enligt figur nedan.

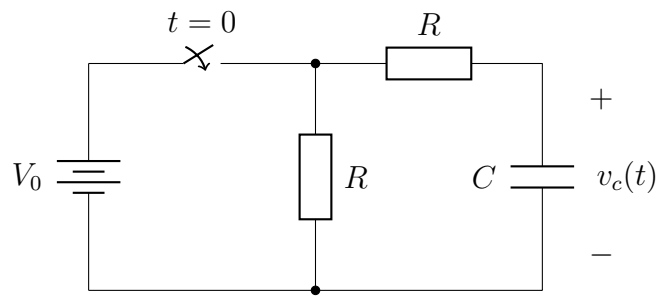


Då spänningen  $v_a - v_b$  läggs mellan halvsfärerna, uppstår strömtätheten

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}) = \frac{J_0}{r^2} \mathbf{e}_r, \quad a < r < b$$

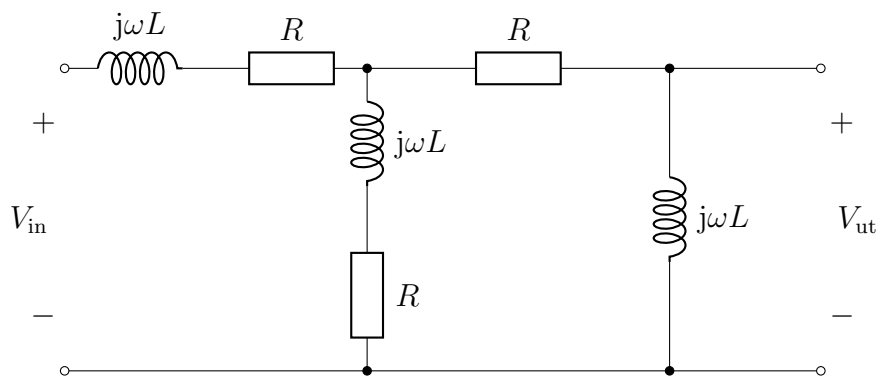
Beräkna resistansen  $R_{ab}$ .

3



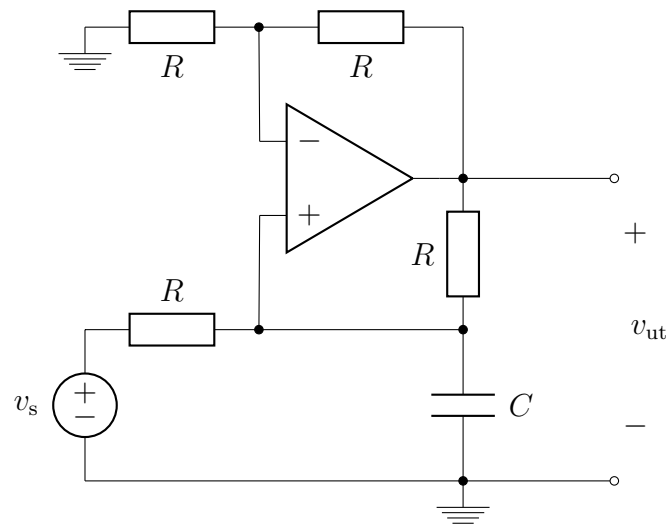
Kapacitansen i kretsen ovan är oladdad vid  $t = 0$ . Kontakten sluts vid  $t = 0$  och öppnas igen när  $v_c(t) = V_0/2$ . Bestäm  $v_c(t)$  för alla tider.

4



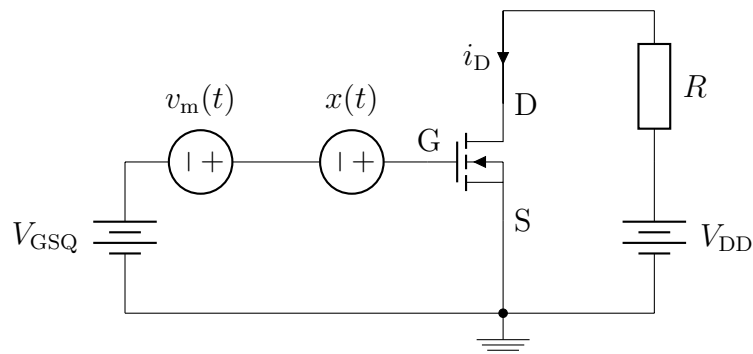
- a) Bestäm överföringsfunktionen  $H = \frac{V_{ut}}{V_{in}}$ .
- b) Vid vilken vinkelfrekvens  $\omega$  är det en fasskillnad av  $45^\circ$  mellan  $V_{ut}$  och  $V_{in}$ ? Uttryck  $\omega$  i  $R$  och  $L$ .

## 5



Bestäm utsignalen  $v_{ut}(t)$  då  $v_s(t) = V_0 \sin(\omega t)H(t)$ , där  $H(t) = 0$  för  $t < 0$  och  $H(t) = 1$  för  $t > 0$ . Operationsförstärkaren kan anses vara ideal.

## 6



Eftersom dioder och transistorer har en olinjär ström- spänningskaraktistik kan de användas för att modulera signaler. I figuren visas en enkel krets med en MOSFET (NMOS) för att illustrera principen. Antag att signalen  $x(t) = A \cos(\omega_1 t)$  ska moduleras med bärvågen  $v_m(t) = M \cos(\omega_c t)$  för att generera signaler med vinkelfrekvenser  $\omega_c \pm \omega_1$ . Tröskelspänningen  $V_{t0}$  och strömmen  $I_{DSS}$  är givna för transistoren. Likspänningarna  $V_{GSQ}$  och  $V_{DD}$  är valda så att transistoren befinner sig i mättnadsområdet.

Bestäm amplituden för frekvenskomponenterna  $\omega_c \pm \omega_1$  genom att identifiera dessa från  $i_D(t)$ .

# Lösningar

## 1

Jorda nod b och använd Kirchhoffs strömlag i nod a:

$$\frac{v - \alpha v}{R} + \frac{v - v_0}{R} + \frac{v - 0}{R} = 0 \quad \Rightarrow \quad v = \frac{v_0}{3 - \alpha} = v_\infty$$

där  $v_\infty$  betecknar tomgångsspänningen. Vid kortslutning är spänningen  $v = 0$ , och vi får kortslutningsströmmen  $i_0 = \frac{v_0}{R}$ . Slutligen fås Thévenin-resistansen som

$$R_{\text{th}} = \frac{v_\infty}{i_0} = \frac{R}{3 - \alpha}$$

Svar: Thévenin-ekvivalenten ges av en spänningskälla  $v_{\text{th}} = \frac{v_0}{3 - \alpha}$  i serie med resistansen  $R_{\text{th}} = \frac{R}{3 - \alpha}$ .

## 2

Med strömfördelningen  $\mathbf{J} = \frac{J_0}{r^2} \mathbf{e}_r$  har vi det elektriska fältet  $\mathbf{E} = \mathbf{J}/\sigma = \frac{J_0}{\sigma r^2}$ , och därmed spänningen

$$v_a - v_b = \int_{r=a}^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \underbrace{\frac{J_0}{\sigma r^2} \mathbf{e}_r}_{=\mathbf{E}} \cdot \underbrace{\mathbf{e}_r dr}_{=dr} = \frac{J_0}{\sigma} \int_a^b \frac{dr}{r^2} = \frac{J_0}{\sigma} \left[ -\frac{1}{r} \right]_a^b = \frac{J_0}{\sigma} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

Den totala strömmen ges av en ytintegral som omsluter hela strömbanan. Denna väljs enklast som en halvsfär med radie  $r = r_0$ , där  $a < r_0 < b$ . Beteckna denna yta med  $S$ , och notera att integralen över den plana gränsytan ( $\mathbf{e}_n = \mathbf{e}_z$ ) ger noll bidrag eftersom strömflödet är parallellt med denna gränsyta).

$$i_{ab} = \int_S \mathbf{J} \cdot \mathbf{e}_n dS = \int_{r=r_0} \underbrace{\frac{J_0}{r^2} \mathbf{e}_r}_{=\mathbf{J}} \cdot \underbrace{\mathbf{e}_r dS}_{=\mathbf{e}_n dS} = \frac{J_0}{r_0^2} \int_{r=r_0} dS = \frac{J_0}{r_0^2} \underbrace{2\pi r_0^2}_{\substack{\text{ytan av en} \\ \text{halv sfär}}} = 2\pi J_0$$

Svar:

$$R_{ab} = \frac{v_a - v_b}{i_{ab}} = \frac{1}{\sigma 2\pi} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

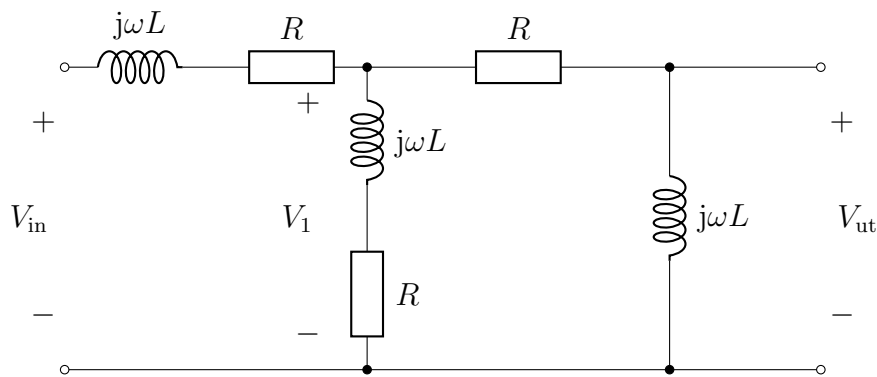
### 3

Då kontakten sluts är kapacitansen oladdad, och kopplas in i serie med en resistans  $R$  och spänningskälla  $V_0$ , dvs  $v_c(t) = V_0(1 - e^{-t/(RC)})$  för  $0 < t < t_0$ . Vid  $t_0 = RC \ln 2$  är  $v_c(t_0) = V_0/2$ , och brytaren öppnas. Kapacitansen laddas då ur genom en resistans  $2R$ , dvs  $v_c(t) = v_c(t_0)e^{-(t-t_0)/(2RC)}$  för  $t > t_0$ .

Svar:

$$v_c(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ V_0(1 - e^{-t/(RC)}) & 0 < t < RC \ln 2 \\ \frac{V_0}{2}e^{-(t-RC \ln 2)/(2RC)} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}e^{-t/(2RC)} & t > RC \ln 2 \end{cases}$$

### 4



Vi börjar med att bestämma  $V_1$ , enligt figur, med spänningsdelning.  $V_1$  ligger över en parallellkoppling av  $Z = R + j\omega L$  med  $Z = j\omega L + R$ , dvs över impedansen  $Z \parallel Z = \frac{1}{2}Z = \frac{1}{2}(R + j\omega L)$ . Detta ger

$$V_1 = \frac{Z/2}{Z + Z/2} V_{\text{in}} = \frac{1}{3} V_{\text{in}}$$

Vi spänningsdelar nu  $V_1$  för att få  $V_{\text{ut}}$

$$V_{\text{ut}} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L} V_1 = \frac{j\omega L}{3(R + j\omega L)} V_{\text{in}}$$

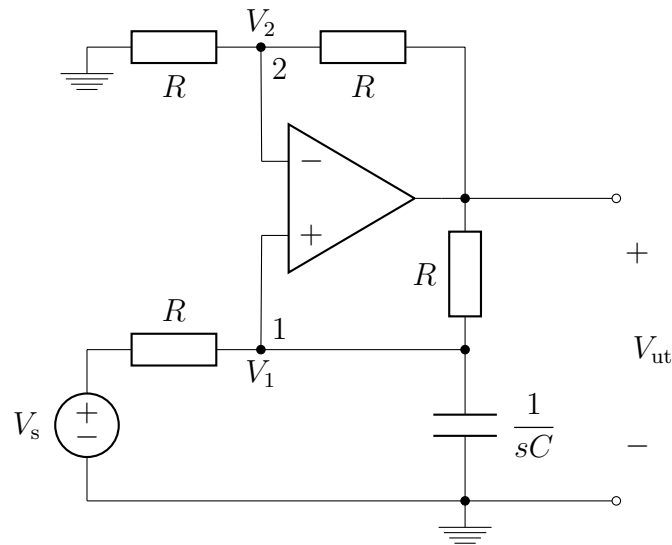
a) Svar:  $H = \frac{j\omega L}{3(R + j\omega L)}$

b)  $H = \frac{\omega L}{3\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} e^{\pi/2 - j \arctan(\omega L/R)}$ . Fasskillnaden är alltså  $\frac{\pi}{2} - \arctan(\omega L/R)$ .

Denna är  $\pi/4$  då  $\omega L = R$ . Det ger

Svar:  $\omega = \frac{R}{L}$

## 5



Transformera kretsen till Laplace-planet enligt ovan. Använd nodanalys på noderna 1 och 2, vilka har samma potential  $V_1 = V_2$ .

$$\begin{aligned} \text{Nod 1:} \quad & \frac{V_1 - V_s}{R} + \frac{V_1 - 0}{\frac{1}{sC}} + \frac{V_1 - V_{\text{ut}}}{R} = 0 \\ \text{Nod 2:} \quad & \frac{V_1 - 0}{R} + \frac{V_1 - V_{\text{ut}}}{R} = 0 \end{aligned}$$

KCL för nod 2 ger  $V_{\text{ut}} = 2V_1$  som insatt i KCL för nod 1 ger

$$V_{\text{ut}}(s) = \frac{2V_s}{sRC} \Rightarrow v_{\text{ut}}(t) = \frac{2}{RC} \int_0^t v_s(\tau) d\tau = \frac{2V_0}{RC} \int_0^t \sin(\omega\tau) d\tau$$

Svar:

$$v_s(t) = \frac{2V_0}{\omega RC} (1 - \cos(\omega t)) H(t)$$

## 6

Strömmen ges av

$$i_D = K (v_{\text{GS}} - V_{t0})^2 \quad (1)$$

i mättnadsområdet. Spänningen  $v_{\text{GS}}(t)$  är

$$v_{\text{GS}}(t) = V_{\text{GSQ}} + M \cos(\omega_c t) + A \cos(\omega_1 t)$$

Insatt i (1)

$$\begin{aligned} i_D(t) &= K (V_{\text{GSQ}} + M \cos(\omega_c t) + A \cos(\omega_1 t) - V_{t0})^2 \\ &= K ((V_{\text{GSQ}} - V_{t0})^2 + M^2 \cos^2(\omega_c t) + A^2 \cos^2(\omega_1 t) + 2(V_{\text{GSQ}} - V_{t0})(M \cos(\omega_c t) + A \cos(\omega_1 t))) \\ &\quad + 2KMA \cos(\omega_c t) \cos(\omega_1 t) \end{aligned}$$

Det är bara den sista termen som innehåller de intressanta termerna (de övriga termerna innehåller DC, ursprungliga frekvenser och dubbla frekvenser). Den sista termen kan skrivas

$$2KMA \cos(\omega_c t) \cos(\omega_1 t) = KMA (\cos([\omega_c + \omega_1]t) + \cos([\omega_c - \omega_1]t))$$

Svar: Amplituden för frekvenskomponenterna  $\omega_c \pm \omega_1$  är  $KMA$ .